



先進パワー半導体分科会 第9回講演会

先進パワー半導体分科会
Advanced Power Semiconductors

開催日：2022年12月20日(火)～21日(水)

開催場所：福岡国際会議場

〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町2-1



基調講演

佐野 賢也 (東芝デバイス&ストレージ株式会社)

「カーボンニュートラル社会に向けた東芝のワイドギャップ半導体戦略(仮)」

西岡 淳 (日立HVDCテクノロジーズ株式会社)

「再生可能エネルギーの大量導入に貢献するHVDC」

山田 健二 (安川電機株式会社)

「パワーエレクトロニクスにおけるWBGデバイスの適用事例と展望」

奨励賞受賞講演

松岡 大雅 (京都大学)

「Hall効果測定によるSiオン注入n型SiC層の電気的性質評価」

浅田 聡志 (電力中央研究所)

「SiCパワーデバイスの通電特性に与える積層欠陥の影響」

招待講演

山本 賢一 (株式会社SkyDrive)

「空の移動革命への挑戦 ～日本発 空飛ぶクルマと物流ドローンの開発～」

川原田 洋 (早稲田大学)

「C-Si-O終端チャネル縦型ダイヤモンドパワー-MOSFET」

金子 光顕 (京都大学)

「高温動作集積回路を目指したSiC相補型JFETの開発」

中原 健 (ローム株式会社)

「パワーデバイスがアプリケーションに与える影響を測る・予測する研究開発」

下山 学 (株式会社SUMCO)

「パワー半導体用シリコンウエーハの最新動向」

佐々木 公平 (株式会社ノベルクリスタルテクノロジー)

「酸化ガリウムの結晶成長とパワーデバイス応用」

庄野 健 (トランスフォームジャパン株式会社)

「1200V耐圧GaNパワートランジスタの開発」

三谷 武志 (産業技術総合研究所)

「溶液法/昇華法を組み合わせたハイブリッド成長法による高品質SiC結晶生産技術開発」

富谷 茂隆 (ソニーグループ株式会社)

TBA

原田 俊太 (名古屋大学)

「次世代パワーデバイス用SiC基板の欠陥評価技術」

東 清一郎 (広島大学)

「光学干渉非接触温度測定法によるパワーデバイス内部における自己発熱温度分布の三次元イメージングとデバイス劣化過程の観測」

原田 信介 (産業技術総合研究所)

「SiCとGaNの融合デバイス開発と将来について」

講演会参加費

	11/30迄*
分科会会員	8,000円
一般	16,000円
分科会学生会員	2,000円
学生一般	4,000円

*12/1以降の料金はHPでご確認ください

実行委員会

実行委員長

寒川 義裕 (九州大学)

実行副委員長

吉武 剛 (九州大学)

郭 其新 (佐賀大学)

実行委員

岡田 成仁 (山口大学)

草場 彰 (九州大学)

原田 俊太 (名古屋大学)

詳細はこちら

<https://annex.jsap.or.jp/adps/scrm09/index.html>

お問い合わせ先：応用物理学会ADPS分科会担当 shiraishi@jsap.or.jp

